

Variante ale circuitelor TTL

- se accentuează anumite performanțe în funcție de aplicațiile cărora le sunt destinate.

Poarta TTL standard cu $t_p = 10ns$ și $P_d = 10mW$; structura este cea prezentată anterior cu valorile rezistențelor precizate;

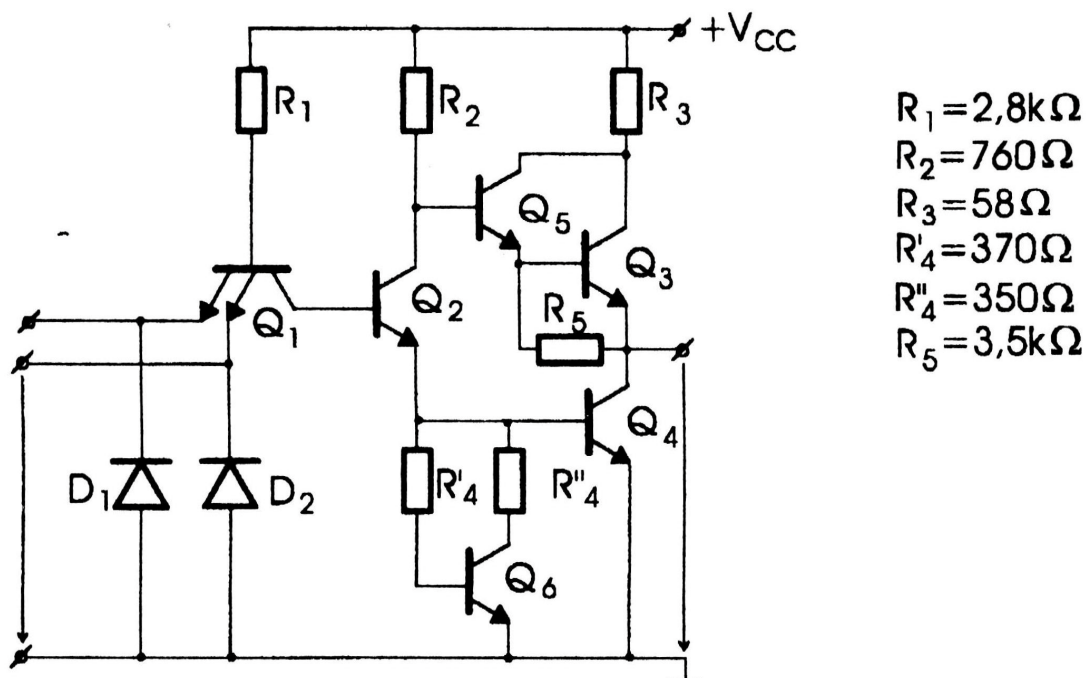
Poarta TTL de mică putere (LPTTL) pentru reducerea consumului:

- aceeași structură ca și poarta standard, dar cu rezistențe de $4 \div 10$ ori mai mari; rezultă:

- consum redus: $2mW$;
- timp de propagare mediu mai mare: $> 20ns$;
- curenți de intrare mai mici;
- curenții disponibili la ieșire mai mici;
- curenți de alimentare mai mici:
 - zgomote proprii mai mici;
 - crește densitatea posibilă a componentelor și a circuitelor;
 - proiectarea termică mai comodă;
 - sursă de alimentare mai puțin solicitată;
 - crește fiabilitatea schemei;
- mai puțin sensibilă la zgomote în impulsuri;
- compatibilitate pin la pin cu poarta standard.

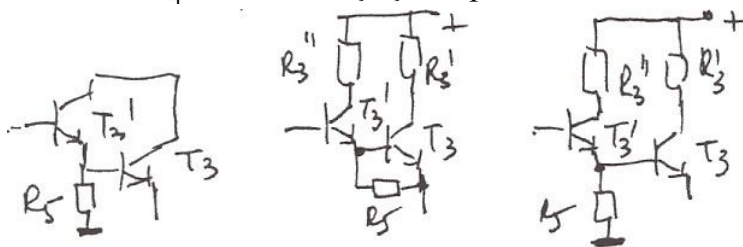
Poarta TTL de viteză mare (HTTL):

- timpul de propagare scade la $6ns$;
- puterea medie disipată crește la $22mW$;



Reducerea timpului de propagare se face prin 3 metode:

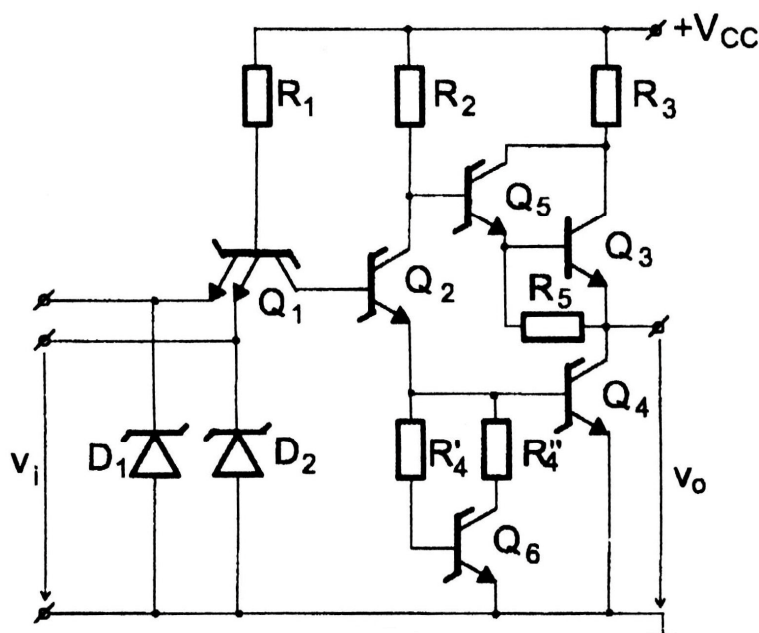
- reducerea rezistențelor cu efect asupra consumului și asupra încărcării provocate de circuit;
- înlocuirea diodei de transpoziție cu un tranzistor (amplificator de curent care asigură curent mai mare în trecerea spre starea logică UNU la ieșire); sunt mai multe variante prezentate în figură;
- înlocuirea rezistenței R_4 cu o sarcină dinamică (formată din tranzistorul T_6 și rezistențele R_4' , R_4'') pentru mărirea curentului de bază la comutarea inversă a tranzistorului T_4 ; are influență și asupra caracteristicii de transfer.



Poarta TTL Schottky (STTL):

- aceeași structură ca HTTL;
- folosește diode Schottky pentru evitarea intrării în saturație;
- timpul de propagare se reduce: $t_p = 3ns$;
- puterea medie disipată este la fel ca la HTTL;

- puterea disipată crește mai încet cu frecvența decât la TTL;
- diodele de evitare a oscilațiilor sunt mai eficiente (se deschid la tensiuni mai mici, de circa $0,4V$);
- marginea de zgomot statică în starea ZERO scade la valoarea $MZL = 0,3V$ deoarece crește $V_{oL} = -V_{DS} + V_{BE} < V_{oL_{max}} = 0,5V$;
- viteze de variație a semnalului la ieșire devine circa $1V/1ns$ (mare) cu consecințe în proiectarea circuitelor – linii lungi de la circa 15 cm;

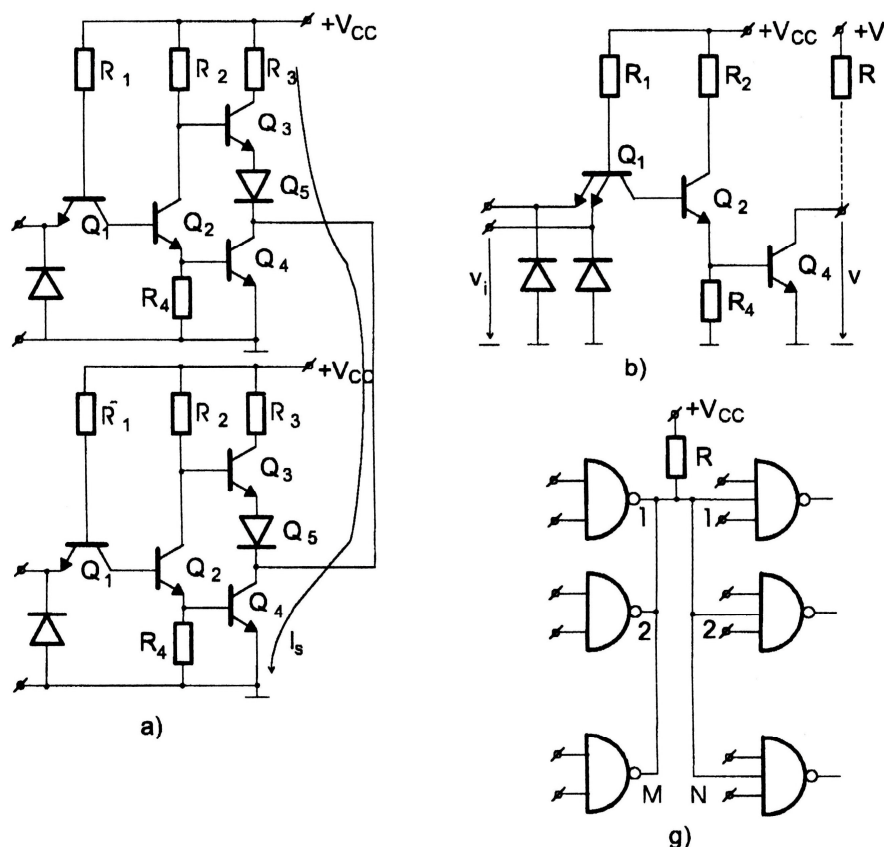


Poarta TTL de mică putere Schottky (LPSTTL):

- structura ca LPTTL;
- timp de propagare ca la TTL standard;
- putere disipată ca la LPTTL; curenți de intrare mici – recomandată pentru interfața cu circuite MOS;

TTL cu colectorul în gol

- realizare magistrale hard – pentru funcții SAU (ȘI) cablat;
- nu se pot pune în paralel porți TTL cu ieșire pe stâlp totemic;
- o variantă – circuitele cu colectorul în gol:



- rezistența de colector se poate cupla și la alte tensiuni de alimentare (se poate realiza interfață cu circuite alimentate la diferite tensiuni de alimentare)
- tranzitoriu – dezavantajele inversorului clasic;
- se pot realiza circuite de întârziere cu o capacitate ca sarcină;
- calculul rezistenței de colector (valori tipice $1 \div 5k\Omega$) dacă:
 - M este numărul de circuite care comandă în paralel;
 - N este numărul de circuite comandate în paralel:

$$R_{\min} < R < R_{\max}$$

- R_{\min} rezultă din condiția de a nu se depăși $I_{oL\max}$ în starea ZERO:

$$I_{oL} = \frac{V_{cc} - V_{oL\max}}{R} + NI_{iL\max} < I_{oL\max}$$

$$R > R_{\min} = \frac{V_{cc} - V_{oL\max}}{I_{oL\max} - NI_{iL\max}}$$

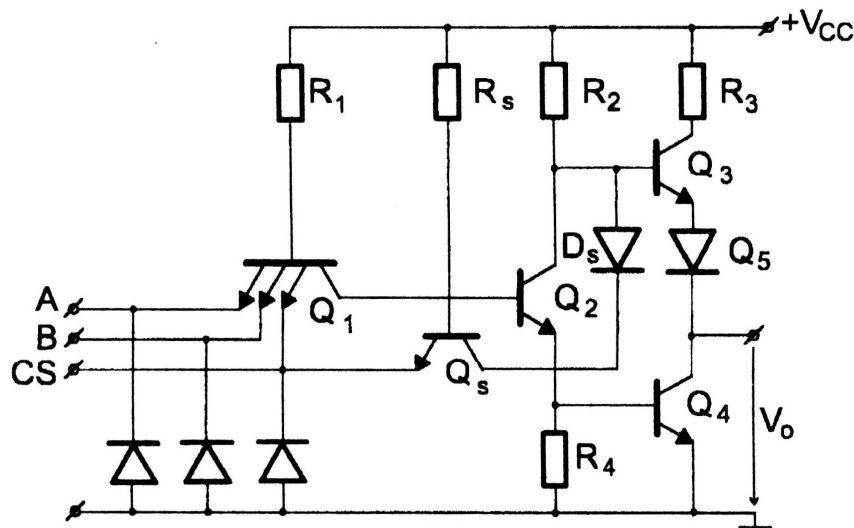
- R_{\max} rezultă din condiția ca tensiunea de ieșire să nu scadă sub $V_{oH\min}$ în starea UNU:

$$V_{oH} = V_{cc} - R(NI_{iH\max} + MI_{o1\max})$$

$$R < R_{\max} = \frac{V_{cc} - V_{oH\min}}{NI_{iH\max} + MI_{o1\max}}.$$

- $I_{01\max}$ este curentul rezidual al tranzistorului T_4 blocat;
- comentarii pentru $N > 7$.

TTL cu trei stări – pentru funcții SAU (ȘI) cablat:



- intrare CS:
 - dacă CS=UNU, T_s și D_s sunt blocate și ieșirea ia valoarea ZERO sau valoarea UNU în funcție de intrările A și B;
 - dacă CS=ZERO, T_s și D_s sunt deschise, tranzistorul T_2 este blocat (prin T_1) și blochează și pe T_4 iar tranzistorul T_3 este blocat (prin dioda suplimentară); rezultă că la ieșire este o impedanță mare (a treia stare) și potențialul să poate fi stabilit de către un alt circuit conectat aici;
 - sunt mai multe variante electrice de blocare a celor două tranzistoare.